

NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ 高周波低雑音増幅用

特 徴

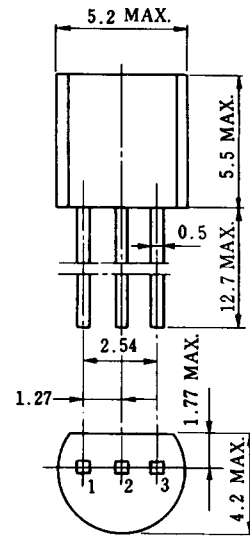
○低雑音, 高利得

NF=1.1 dB $G_a=8.0$ dB @f=1 GHz, $V_{CE}=10$ V, $I_C=7$ mA

NF=1.8 dB $G_a=9.0$ dB @f=1 GHz, $V_{CE}=10$ V, $I_C=40$ mA

○高電力利得 MAG 11.5 dB, TYP. @f=1 GHz

外形図 (単位: mm)



電極接続

1. ベース EIAJ : SC-43B
2. エミッタ JEDEC : TO-92
3. コレクタ IEC : PA33

絶対最大定格 ($T_A=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	20	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	12	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	3.0	V
コレクタ電流	I_C	100	mA
全 損 失	P_T	600	mW
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-65~+150	$^\circ\text{C}$

電気的特性 ($T_A=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=10$ V, $I_E=0$			1.0	μA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=1$ V, $I_C=0$			1.0	μA
直 流 電 流 増 幅 率	h_{FE} *	$V_{CE}=10$ V, $I_C=20$ mA	50	120	300	
利 得 帯 域 幅 積	f_T	$V_{CE}=10$ V, $I_C=20$ mA		6.5		GHz
コ レ ク タ 容 量	C_{ob} **	$V_{CB}=10$ V, $I_E=0$, $f=1.0$ MHz		0.65	1.0	pF
順 方 向 伝 達 利 得	$ S_{21e} ^2$	$V_{CE}=10$ V, $I_C=20$ mA, $f=1.0$ GHz		9.5		dB
雑 音 指 数	NF	$V_{CE}=10$ V, $I_C=7$ mA, $f=1.0$ GHz		1.1		dB
雑 音 指 数	NF	$V_{CE}=10$ V, $I_C=40$ mA, $f=1.0$ GHz		1.8	3.0	dB

* パルス測定 $PW \leq 350 \mu\text{s}$, Duty Cycle $\leq 2\%$

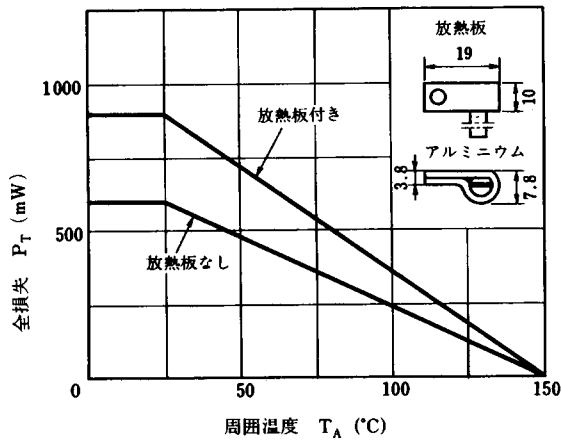
** 3端子ブリッジにて測定し, エミッタおよびベース端子はブリッジのガード端子に接続する。

h_{FE} 規格区分

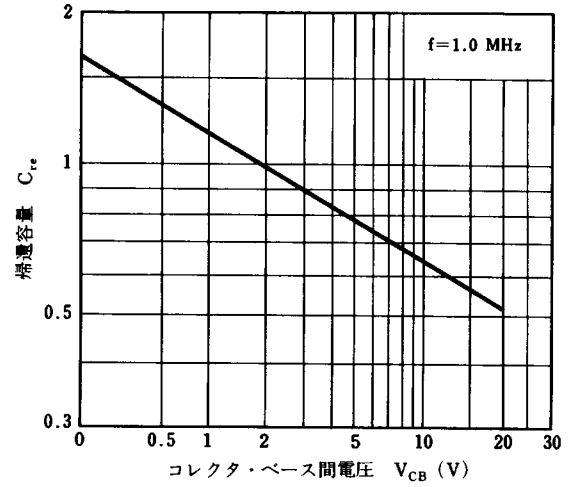
規格	K
捺印	K
h_{FE}	50~300

特性曲線 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

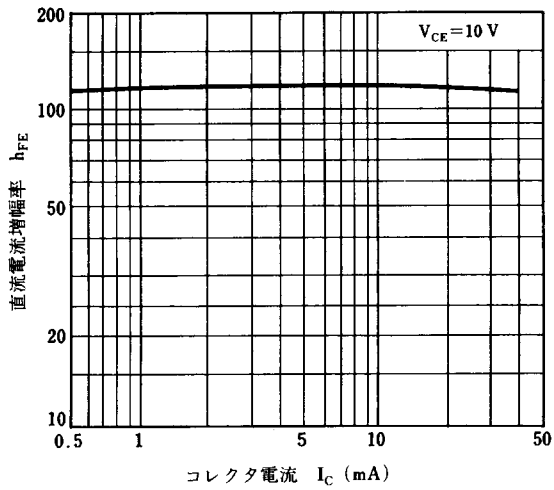
TOTAL POWER DISSIPATION vs. AMBIENT TEMPERATURE



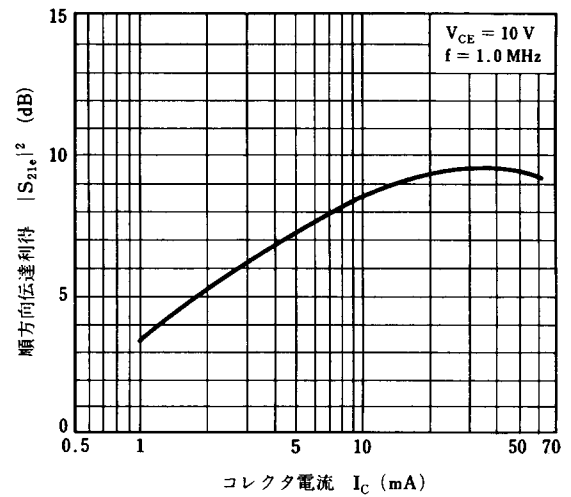
FEEDBACK CAPACITANCE vs. COLLECTOR TO BASE VOLTAGE



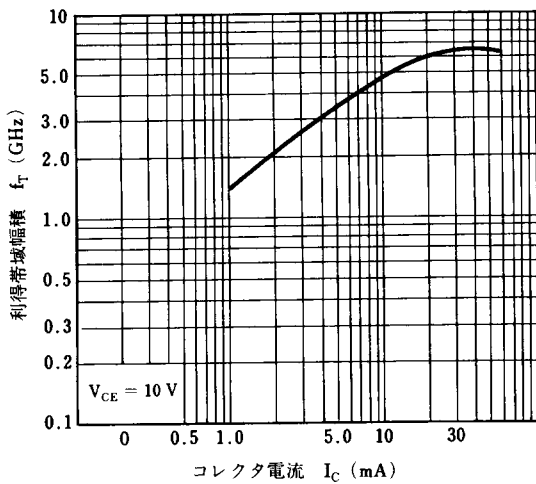
DC CURRENT GAIN vs. COLLECTOR CURRENT



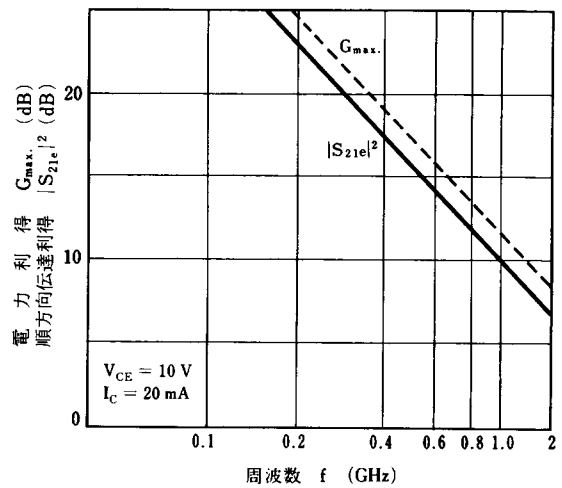
INSERTION GAIN vs. COLLECTOR CURRENT

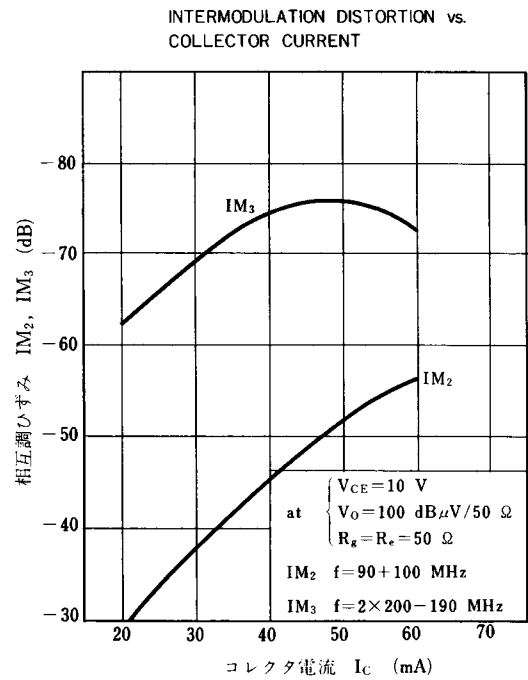
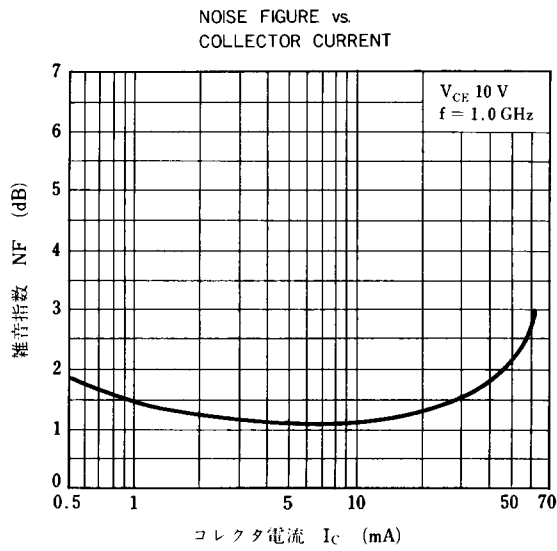


GAIN BANDWIDTH PRODUCT vs. COLLECTOR CURRENT



INSERTION GAIN, MAXIMUM GAIN vs. FREQUENCY





Sパラメータ

$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 20\text{ mA}, Z_0 = 50\ \Omega$

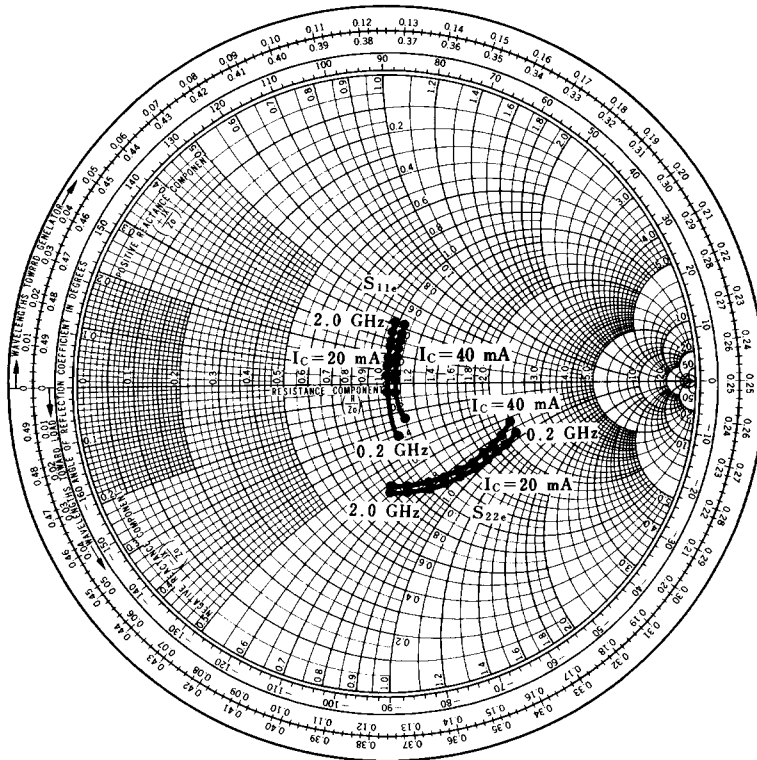
f(MHz)	$ S_{11} $	$\angle S_{11}$	$ S_{21} $	$\angle S_{21}$	$ S_{12} $	$\angle S_{12}$	$ S_{22} $	$\angle S_{22}$
200	0.173	-80.3	13.652	103.4	0.041	73.8	0.453	-21.8
400	0.054	-77.0	7.217	85.1	0.066	71.2	0.427	-26.0
600	0.013	-57.9	4.936	74.0	0.113	69.3	0.428	-30.8
800	0.028	81.8	3.761	62.3	0.144	67.0	0.414	-37.2
1000	0.062	82.2	3.094	58.3	0.183	64.7	0.392	-43.2
1200	0.091	80.7	2.728	52.9	0.215	61.7	0.377	-51.4
1400	0.121	80.2	2.321	44.9	0.240	58.7	0.359	-58.3
1600	0.148	80.1	2.183	36.4	0.288	50.7	0.354	-67.2
1800	0.171	80.0	1.892	30.2	0.305	46.8	0.345	-80.0
2000	0.207	79.9	1.814	21.4	0.344	39.1	0.344	-90.4

$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 40\text{ mA}, Z_0 = 50\ \Omega$

f(MHz)	$ S_{11} $	$\angle S_{11}$	$ S_{21} $	$\angle S_{21}$	$ S_{12} $	$\angle S_{12}$	$ S_{22} $	$\angle S_{22}$
200	0.011	-60.1	13.76	105.4	0.040	-73.3	0.421	-17.5
400	0.028	-42.9	7.338	82.9	0.069	66.7	0.416	-22.8
600	0.027	25.1	4.996	72.7	0.114	69.4	0.414	-28.7
800	0.043	65.7	3.801	61.9	0.144	67.8	0.406	-35.7
1000	0.074	75.1	3.134	57.6	0.183	63.4	0.386	-41.8
1200	0.098	75.6	2.759	52.4	0.221	62.1	0.373	-49.8
1400	0.120	74.1	2.351	44.4	0.247	55.7	0.356	-56.3
1600	0.146	75.8	2.203	36.0	0.291	49.6	0.347	-66.6
1800	0.171	77.2	1.910	29.9	0.299	46.0	0.342	-78.8
2000	0.205	78.0	1.825	21.3	0.344	39.4	0.335	-89.6

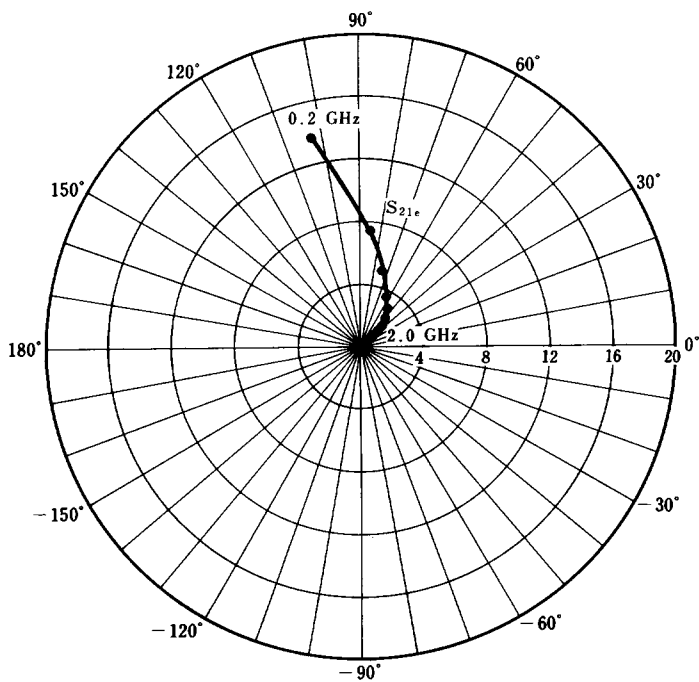
S_{11e} , S_{22e} -FREQUENCY

CONDITION $V_{CE}=10\text{ V}$



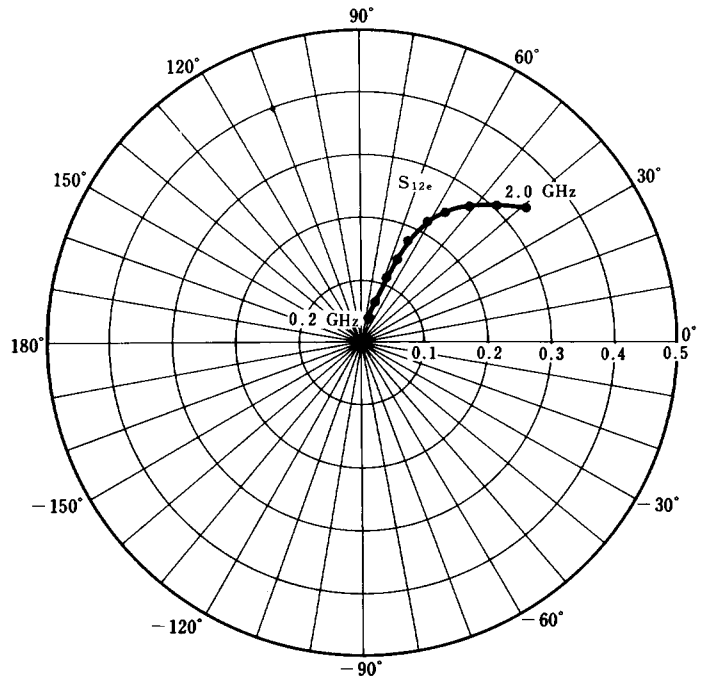
S_{21e} -FREQUENCY

CONDITION $V_{CE}=10\text{ V}$
 $I_C=40\text{ mA}$



S_{12e} -FREQUENCY

CONDITION $V_{CE}=10\text{ V}$
 $I_C=40\text{ mA}$



(X E)

[メ モ]

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
 当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。
- この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

— お問い合わせは、最寄りのNECへ —

【営業関係お問い合わせ先】

半導体第一販売事業部 半導体第二販売事業部 半導体第三販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)	東京 (03)3454-1111 (大代表)
中部支社 半導体販売部	〒460 名古屋市中区錦一丁目17番1号 (NEC中部ビル)	名古屋 (052)222-2170
関西支社 半導体第一販売部 半導体第二販売部 半導体第三販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大阪 (06) 945-3178 大阪 (06) 945-3200 大阪 (06) 945-3208
北海道支社 札幌 (011)231-0161 東北支社 仙台 (022)261-5511 岩手支店 盛岡 (0196)51-4344 山形支店 山形 (0236)23-5511 郡山支店 郡山 (0249)23-5511 いわき支店 いわき (0246)21-5511 長岡支店 長岡 (0258)36-2155 土浦支店 土浦 (0298)23-6161 水戸支店 水戸 (0292)26-1717 神奈川支社 横浜 (045)324-5511 群馬支店 高崎 (0273)26-1255 太田支店 太田 (0276)46-4011 宇都宮支店 宇都宮 (0286)21-2281	小山支店 小山 (0285)24-5011 長野支社 長野 (0262)35-1444 松本支店 松本 (0263)35-1666 上諏訪支店 上諏訪 (0266)53-5350 甲府支店 甲府 (0552)24-4141 埼玉支店 大立 (048)641-1411 立川支店 立川 (0425)26-5981 千葉支店 千葉 (043)238-8116 静岡支店 静岡 (054)255-2211 沼津支店 沼津 (0559)63-4455 浜松支店 浜松 (053)452-2711 北陸支店 金沢 (0762)23-1621 福井支店 福井 (0776)22-1866	富山支店 富山 (0764)31-8461 三重支店 津 (0592)25-7341 京都支社 京都 (075)344-7824 神戸支社 神戸 (078)333-3854 中国支社 広島 (082)242-5504 鳥取支店 鳥取 (0857)27-5311 岡山支店 岡山 (086)225-4455 四国支社 高松 (0878)36-1200 新居浜支店 新居浜 (0897)32-5001 松山支店 松山 (0899)45-4111 九州支社 福岡 (092)271-7700 北九州支店 北九州 (093)541-2887

【本資料に関する技術お問い合わせ先】

半導体ソリューション技術本部 超高周波・光デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地	川崎 (044)548-8881	半導体 インフォメーションセンター FAX(044)548-7900 (FAXにてお願い致します)
半導体販売技術本部 東日本販売技術部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)	東京 (03)3798-9619	
半導体販売技術本部 中部販売技術部	〒460 名古屋市中区錦一丁目17番1号 (NEC中部ビル)	名古屋 (052)222-2125	
半導体販売技術本部 西日本販売技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大阪 (06) 945-3383	